

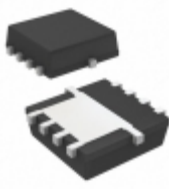

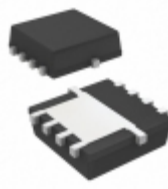
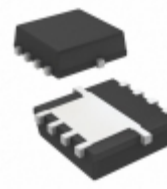
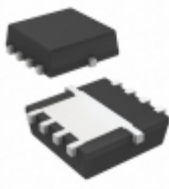

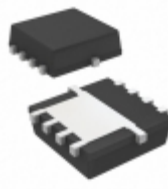

	<h2>SI7112DN-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7112DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7112DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22635 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7112DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22635 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 17.8A, 10V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2610pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.3A (Tc)

SI7112DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7112DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7112DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7112DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7112DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8</p>	 <p>SI7112DN VISHAY VISHAY QFN-8</p>	 <p>SI7113ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 10.8A 1212-8</p>	 <p>SI7113DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 13.2A 1212-8</p>
 <p>SI7113DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 13.2A 1212-8</p>	 <p>SI7113DN SI SI7113DN SI</p>	 <p>SI7113DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 13.2A 1212-8</p>	 <p>SI7112DN-T1 VISHAY SI7112DN-T1 VISHAY</p>

SI7112DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI7112DN-T1-GE3	Vishay / Siliconix	SI7112DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7112DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7112DN-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI7112DN-T1-GE3
SI7112DN-T1-GE3 Electronic	SI7112DN-T1-GE3 Komponenten	SI7112DN-T1-GE3 Hersteller	SI7112DN-T1-GE3 Verteiler	SI7112DN-T1-GE3-Bild	SI7112DN-T1-GE3-Teil
SI7112DN-T1-GE3 Preis	SI7112DN-T1-GE3 Original	SI7112DN-T1-GE3 Bild	SI7112DN-T1-GE3 garantiert	SI7112DN-T1-GE3 Aktie	SI7112DN-T1-GE3 Inventar
SI7112DN-T1-GE3 Neu	SI7112DN-T1-GE3 Original	SI7112DN-T1-GE3 garantiert	SI7112DN-T1-GE3 RFQ	SI7112DN-T1-GE3 Online bestellen	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited